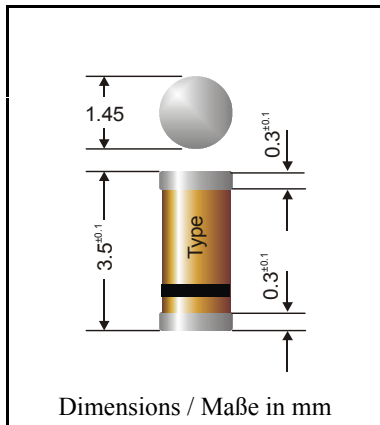


**Surface Mount Si-Schottky Barrier Diodes**

**Silizium-Schottky-Dioden  
für die Oberflächenmontage**



Nominal current Nennstrom	0.2 A
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	20...40 V
Glass case MiniMELF Glasgehäuse MiniMELF	SOD 80 DO-213AA
Weight approx.– Gewicht ca.	0.05 g
Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rolle	see page 18 siehe Seite 18

**Maximum ratings and Characteristics**

**Grenz- und Kennwerte**

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Period. Spitzensperrspannung $V_{RRM}$ [V]	Forward voltage Durchlaßspannung $V_F$ [V] / $I_F = 20$ mA	$V_F$ [V] / $I_F = 200$ mA
LL 103C	20	< 0.37	< 0.6
LL 103B	30	< 0.37	< 0.6
LL 103A	40	< 0.37	< 0.6

Power dissipation – Verlustleistung	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$P_{tot}$	400 mW <sup>1)</sup>
Peak forward surge current, 60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 60 Hz Sinus-Halbwellen	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$I_{FSM}$	15 A
Leakage current – Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$	$I_R < 5 \mu\text{A}$
Junction capacitance Sperrschichtkapazität	$V_R = 0$ V	$f = 1$ MHz	$C_{tot}$ typ. 50 pF
Reverse recovery time Sperrverzögerung	$I_F = 200$ mA through/über $I_R = 200$ mA to/auf $I_R = 20$ mA	$t_{rr}$	typ. 10 ns
Junction temperature – Sperrschichttemperatur		$T_j$	+125°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur		$T_S$	- 55...+175°C
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft		$R_{thA}$	< 300 K/W <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Valid provided that terminals are kept at ambient temperature  
Gültig wenn Anschlüsse auf Umgebungstemperatur gehalten werden